Catalogue produits

Amplificateurs de puissance LDMOS

Les amplificateurs de puissance LDMOS utilisent des transistors MOS à diffusion latérale pour augmenter la puissance RF. Adaptation, polarisation, crêtes du signal et chemin thermique complet fixent les limites d'emploi.



Produits: 2

Révision: 2 · Date de révision: 2026-11-11



LCPAM-20-520-200A

Module amplificateur de puissance RF LDMOS 20–520 MHz, 200 W en saturation

Ce module à étage final LDMOS couvre 20–520 MHz avec 200 W de puissance saturée typique. La puissance au point de compression de 1 dB est spécifiée séparément à 50 W typiques ; le gain petit signal typique est de 53 dB.

Fréquence de fonctionnement: Symbole: BW; Minimum: 20; Maximum: 520; Unité: MHz

Puissance RF de sortie saturée: Symbole: Psat; Typique: 200; Unité: W

Puissance de sortie à la compression de 1 dB: Symbole: P1dB; Typique: 50; Unité: W

Gain petit signal: Symbole: G; Typique: 53; Unité: dB

25 °C; 50 Ω

Détails du produit Fiche technique produit



LCPAM-20-520-350

Amplificateur LDMOS RF 20–520 MHz, sortie saturée typique 350 W

L'amplificateur LDMOS couvre 20–520 MHz avec 350 W typiques en sortie saturée et 150 W typiques à la compression de 1 dB. Le gain typique est 56 dB, le courant 29 A à 350 W et l'alimentation typique 48 VDC.

Fréquence de fonctionnement: Symbole: BW; Minimum: 20; Maximum: 520; Unité: MHz

Puissance de sortie à la compression de 1 dB: Symbole: P-1dB; Typique: 150; Unité: W

Puissance de sortie RF @ PSAT: Symbole: PSAT; Typique: 350; Unité: W

Gain de puissance @ PSAT: Symbole: Gp; Typique: 56; Unité: dB

+48.0VDC; 25°C; 50Ω

Détails du produit Fiche technique produit

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.